

日本学術振興会145委員会第169回研究会

ワイドバンドギャップ半導体の p 型制御

日時：2020年12月18日（金）13:10–17:50

場所：Web 開催

世話人：太子敏則(信州大)、石川由加里((一財)ファインセラミックスセンター)、末岡浩治
(岡山県立大)

13:10–13:15 委員長挨拶

13:15–13:25 はじめに

13:25–14:05 「GaN パワーデバイスのための p 型形成技術の進展と課題」

豊田中央研究所 成田 哲生

14:05–14:45 「第一原理計算による Ga₂O₃ p 型ドーピングの可能性検討」

(一財) ファインセラミックスセンター 小川 貴史

14:45–15:25 「Ga₂O₃ 中間電子構造利用による p 型伝導 (仮)」

京都工芸繊維大学 西中 浩之

15:25–15:45 休憩

15:45–16:25 「ダイヤモンド ホッピング伝導を利用した p 型伝導 (仮)」

産総研 つくば 牧野 俊晴

16:25–17:05 「AlGa_N/Ga_N の分極を利用した p 型伝導 (仮)」

名城大学 竹内 哲也

17:05–17:45 「半導体におけるドーピングの全体像とフェルミレベル効果」

北陸先端科学技術大学院大学 徳光 永輔

17:45–17:50 おわりに